

БКО.347.222-02 ТУ

573РФ2

16К (2Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

НМОП технология

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность длительного хранения информации при включенном и отключенном питании и многократной смены информации.

Предназначено для работы в блоках памяти специализированных электронно-вычислительных машин, в устройствах сбора и обработки информации, устройствах информатики и контроля.

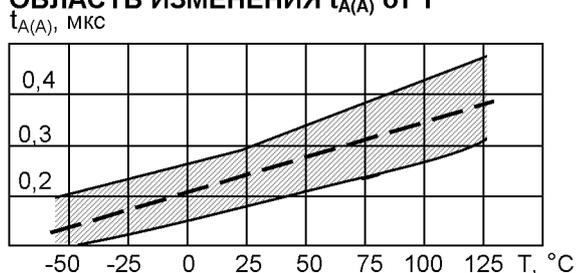
- время выборки адреса 450нс;
- напряжение питания $5В \pm 10\%$;
- напряжение сигнала записи-считывания в момент программирования $24,5В \pm 0,5В$;
- допустимое значение статического потенциала не более 200В.



НАДЕЖНОСТЬ

Наработка, ч	$t_{и}$	100 000
Срок хранения, лет	$t_{хр}$	25

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ $t_{A(A)}$ ОТ Т



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1-8, 19, 22, 23	A1-A11	Вход адресный
9 -11, 13 -17	D1-D8	Вход-выход
12	OV	Общий
18	\overline{CE}	Вход сигнала разрешения обращения
20	\overline{OE}	Вход сигнала разрешения выхода
21	WR/RD	Вход сигнала записи-считывания
24	U_{CC}	Источник питания

ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

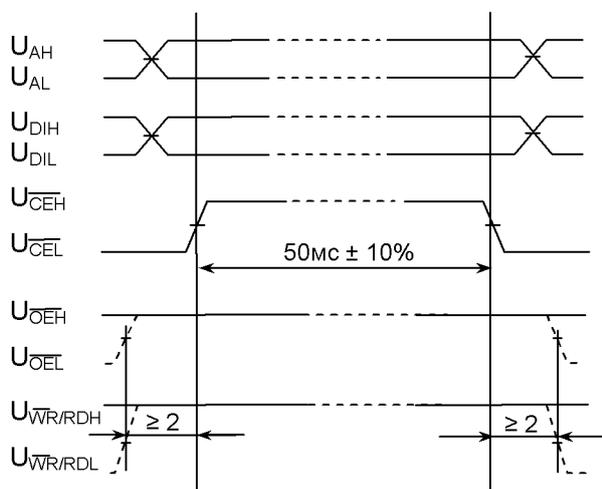
Механические удары, g	1500
Линейное ускорение, g	20 000
Вибрация 1 - 5 000 Гц, g	40
Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси	1:1

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до 85
Изменение температуры среды, °С	от - 60 до 125
Повышенная влажность при Т = 35 °С, %	до 98
Температура пайки, °С	235 ± 5
Продолжительность, с	2 ± 0,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ($U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 10\%$)

Символ	Параметр	T, °C	573PФ2
U_{DOL}	Напряжение выхода низкого уровня, В ($I_{OL} = 2,1 \text{ мА}$)	от - 60 до 85	$\leq 0,45$
U_{DOH}	Напряжение выхода высокого уровня, В ($I_{OH} = 0,4 \text{ мА}$)	от - 60 до 85	$\geq 2,4$
I_{CC}	Ток потребления в режиме считывания, мА	25, 85 - 60	≤ 80 ≤ 110
$I_{WR/RD}$	Ток сигнала записи-считывания, мА	25, 85 - 60	≤ 6 ≤ 10
I_{CCS}	Ток потребления в режиме хранения, мА	25, 85 - 60	≤ 21 ≤ 35
$I_{WR/RDS}$	Ток сигнала записи-считывания в режиме хранения, мА	от - 60 до 85	≤ 2
I_{LI}	Ток утечки по каждому входу, мкА	от - 60 до 85	≤ 10
$t_{A(A)}$	Время выборки адреса, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,45$
$t_{A(CE)}$	Время выборки разрешения обращения, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,45$
$t_{A(OE)}$	Время выборки разрешения выхода, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,25$
t_{SG1}	Время хранения информации при отключённом питании, ч	85 от - 60 до 25	$\geq 25 \text{ 000}$ $\leq 100 \text{ 000}$
t_{SG2}	Время хранения информации при включённом питании, ч	от - 60 до 85	$\geq 25 \text{ 000}$
C_I	Входная ёмкость вывода вход-выход, пФ	от - 60 до 85	≤ 12
N_{CY}	Количество циклов перепрограммирования, цикл	25 ± 10	≥ 100

ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ


Тепловое сопротивление кристалл - корпус $0,05^\circ\text{C}/\text{мВт}$.

Предельное значение температуры перехода (кристалла) 130°C при $T_{\text{окр.ср.}} = 85^\circ\text{C}$.

Время стирания информации, с.

$$t_{EE} = \frac{H_E}{E_E}, \quad \text{где}$$

E_E – измеренное значение энергетической освещённости в плоскости окна корпуса, $\text{Вт}/\text{м}^2$;
 $H_E = 1,5 \cdot 10^5 \text{ Вт} \cdot \text{с}/\text{м}^2$ – требуемое значение энергетической экспозиции для стирания информации в микросхеме.

Стирание информации проводят путём воздействия ультрафиолетового излучения с длиной волны $253,7 \text{ нм}$;

Возможна запись информации серией импульсов последовательно по одному импульсу в каждый адрес.